

Notice No: 9-5-2004-053340511 To : 3rd Fl., 827-25, Yeoksam-dong,  
Date of Notice: 2004.12.17 Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  
Due Date: 2004.02.17. (Koryo International Patent & Law Office)  
Chang-Hyun Yim, Esq. 135-080

The Korean Intellectual Property Office  
Notice to File a Response/Amendment to the Examination Report

Applicant Name Samsung Electronics Co., Ltd.  
(Applicant's code: 119981042713)  
Address 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si,  
Gyeonggi-do, Republic of Korea  
Attorney Name Chang-Hyun Yim et al.  
Address 3rd Fl., 827-25, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul,  
Republic of Korea (Koryo International Patent & Law Office)  
Application No. 10-2003-0008202  
Title of the Invention FERROELECTRIC MEMORY DEVICE AND METHOD FOR  
FABRICATING THE SAME

As a result of examination in this application, this Notice is issued for the below reason(s) under Article 63 of Patent Law, and if any comment or amendment is required, a response or an amendment should be submitted by the above-mentioned due date (Time for responding can be extended monthly each time, and Notice of approval for the time extension will not be issued).

[Reason]

- Claims 1-37 are rejected under Korean Patent Law Article 29(2) as being easily made by those skilled in the art on the basis of Korean Patent Publication Nos. 2002-97479 and 1998-40642 (published on December 31, 2002 and August 17, 1998; hereinafter referred to as "cited reference 1" and "cited reference 2", respectively).

GROUND

-Regarding claims 1-18,

The Examiner recognizes that the claimed invention is characterized in a ferroelectric memory device having a reaction buffer layer.

RE~~ST~~ AVAILABLE COPY

The cited reference 1 discloses

**"a ferroelectric memory having a residual ferroelectric layer and a reaction preventing layer"**

The cited reference 2 discloses

**"a ferroelectric capacitor having an oxygen diffusion preventing layer"**

Accordingly, the present invention is easily made by those skilled in the art upon the cited references 1 and 2. (Patent Act 29(2))

-Regarding claims 19-37,

The Examiner recognizes that the claimed invention is characterized in a method for fabricating a ferroelectric memory device comprising a step of forming a reaction buffer layer.

The cited reference 1 discloses

**"a method for fabricating a ferroelectric memory comprising a step of forming a residual ferroelectric layer and a reaction preventing layer"**

The cited reference 2 discloses

**"a method for fabricating a ferroelectric capacitor comprising a step of forming an oxygen diffusion preventing layer"**

Accordingly, the present invention is easily made by those skilled in the art upon the cited references 1 and 2.

Enclosure: 1. Korean Patent Publication No. 2002-97479 (Publication Date: 2002.12.31)

2. Korean Patent Publication No. 1998-40642 (Publication Date: 1998.08.17) End

December 27, 2004

Electricity Electron Device Examination Division, Intellectual Property Office

Examiner Kim, Geun-Mo

<<Information>>

If you have inquiry, call 042-481-5985

**BEST AVAILABLE COPY**

출력 일자: 2004/12/20

발송번호 : 9-5-2004-053340511  
발송일자 : 2004.12.17  
제출기일 : 2005.02.17

수신 : 서울 강남구 역삼동 827-25 3층 (고려국  
제특허법률사무소)  
임창현 귀하

135-080

## 특허청 의견제출통지서

출원인	명칭 삼성전자주식회사 (출원인코드: 119981042713) 주소 경기도 수원시 영통구 매탄동 416
대리인	성명 임창현 외 1 명 주소 서울 강남구 역삼동 827-25 3층 (고려국제특허법률사무소)
출원번호	10-2003-0008202
발명의 명칭	강유전체 메모리 소자 및 그 제조방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장 승인을 받지 않습니다.)

### [이유]

이 출원의 특허청구범위 제1-37항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[ 아래 ]

[ 아래 ]

1. 청구항 제1-18항의 반응완충막을 갖는 강유전체 메모리 소자는 인용발명1(한국공개특허공보 2002-97479호(2002.12.31))의 잔류 강유전체막, 반응방지막을 갖는 강유전체 메모리 및 인용발명2(한국공개특허공보 1998-40642호(1998.08.17))의 산소 확산 방지막을 갖는 강유전체 캐패시터 등에서 용이하게 빌명 할 수 있는 것입니다.(특허법 제29조제2항)
2. 청구항 제19-37항의 반응완충막을 형성하는 단계를 갖는 강유전체 메모리 소자 제조방법은 인용발명1의 잔류 강유전체막, 반응방지막을 형성하는 단계를 갖는 강유전체 메모리 제조방법 및 인용발명2의 산소 확산 방지막을 형성하는 단계를 갖는 강유전체 캐패시터 제조방법 등에서 용이하게 빌명 할 수 있는 것입니다.(특허법 제29조제2항)

### [첨 부]

첨부 1 공개특허 제2002-97479호(2002.12.31) 1부.  
첨부2 공개특허 제1998-40642호(1998.08.17) 1부. 끝.

2004. 12. 17

## 특허청

## 전기전자심사국

## 응용소자심사담당관실

## 심사관 김근모



**BEST AVAILABLE COPY**

출력 일자: 2004/12/20

<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5985 로 문의하시기 바랍니다.  
서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 콜센터 ☎ 1544-8080으로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.  
▶ 홈페이지 ([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))내 부조리신고센터

BEST AVAILABLE COPY